Cバンド 20K 冷却高電界 RF 電子銃による 高品質電子ビーム引き出しの可能性

日本大学 量子科学研究所 電子線利用研究施設

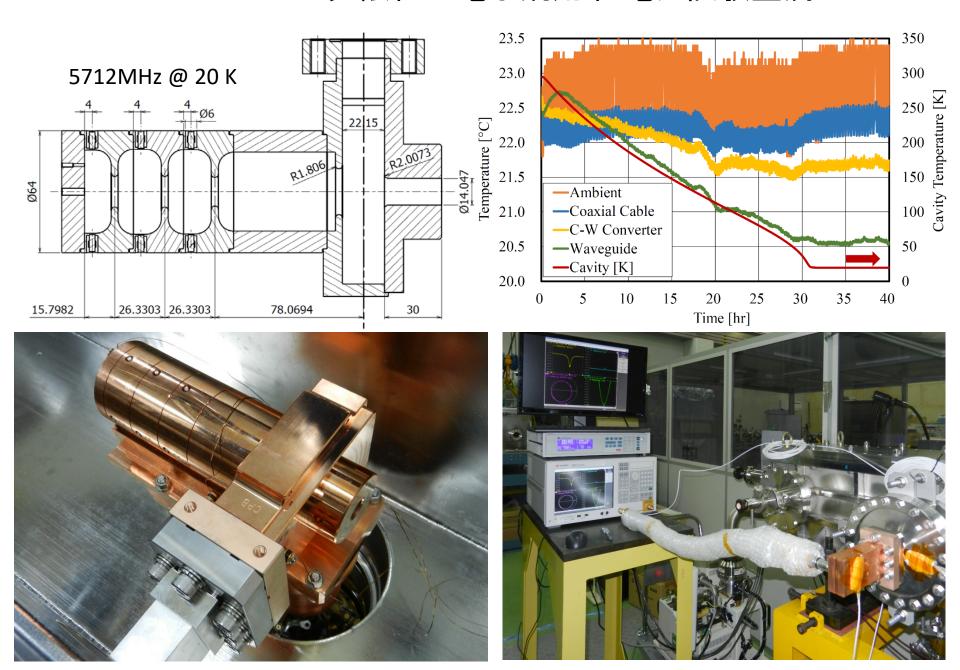
田中俊成,境武志,早川建,早川恭史,野上杏子,住友洋介,山田靖征,吉田昂斗,佐藤勇

研究の背景と動機

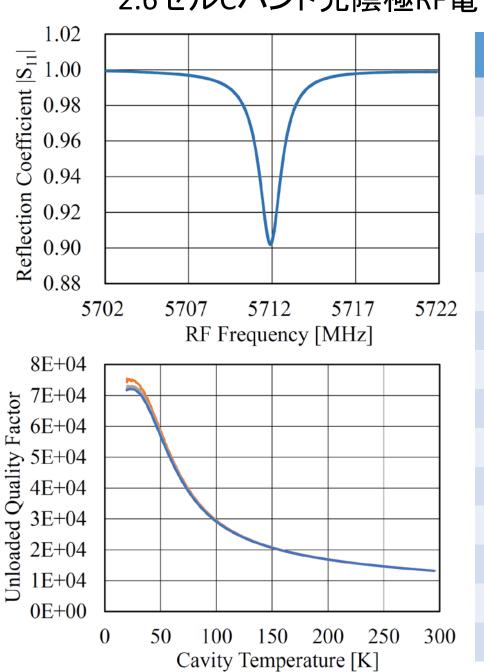
光・量子融合連携開発研究プログラム 「小型加速器による小型高輝度X線源とイメージング基盤技術開発」 (KEK 浦川、照沼氏)

- クライオ光陰極高周波電子銃開発(日大、KEK)
 - 20K程度までの冷却は素人でも容易
 - 常伝導だが表面抵抗の低下を利用した低損失空洞
 - 大電力RF試験による動作の検証はプログラムでは未達成
- SLACにおける Xバンド空洞の高電界試験結果
 - 銅合金による高硬度材料空洞による高電界での低放電頻度
 - 45K冷却純銅空洞において、さらに高電界でも低放電頻度を達成
 - 放電頻度の電界強度依存性に対する欠陥モデルとの整合性
- トヤマ・KEKによるクライオ進行波加速管の開発と大電力試験
 - 低温下において電界放出電子が少ない

2.6セルCバンド光陰極RF電子銃用 低電力試験空洞

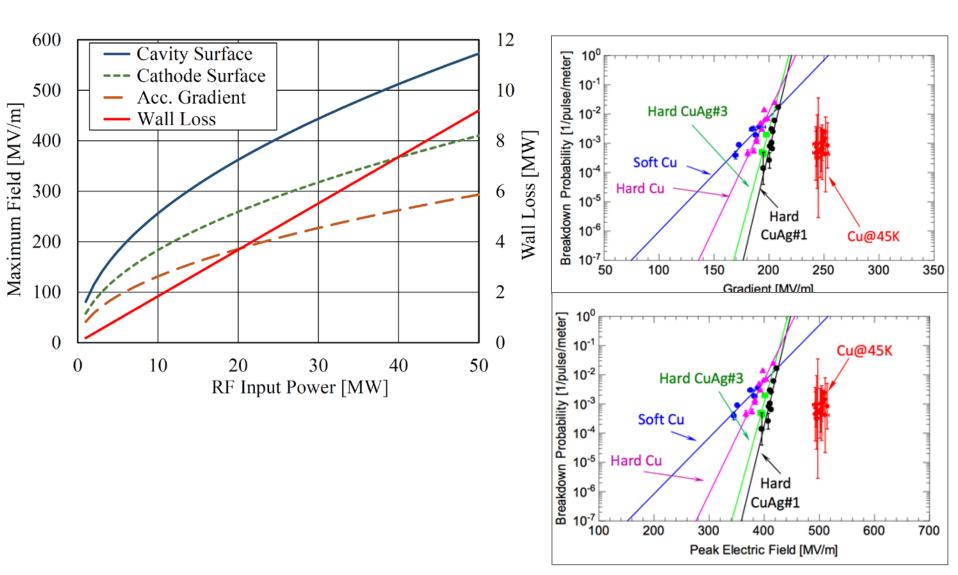


2.6セルCバンド光陰極RF電子銃用 低電力試験空洞



低電力試験に基づくRF電	子銃空洞	の仕様
共振周波数	5712	MHz
加速空洞長	68.2	mm
無負荷Q値	73000	
結合係数	19.7	
負荷Q値	3526	
電場立上り時間	196	ns
シャントインピーダンス	624	MΩ/m
ピーク入力RF電力	4	MW
パルス幅	2	μs
繰返し	50	pps
平均空洞損失	73.6	W
バンチ当たり電荷量	0.5	nC
最大表面電界	162	MV/m
最大カソード面電界	116	MV/m
加速勾配	83	MV/m

大電力RF(>4 MW)入力時の2.6セル空洞内における高電界発生



V. Dolgashev, 2nd European Advanced Accelerator Concepts Workshop (EAAC 2015) La Biodola, Isola d'Elba, Italy, 13-19 September 2015

銅表面をカソードとした場合の量子効率とエミッタンス

銅表面付近のポテンシャルエネルギー

$$\phi(x) = -eE_{RF}x - \frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0 x}$$

ポテンシャルエネルギー最大値

$$\phi_{\text{max}} = -\sqrt{e^3 E_{\text{RF}}/4\pi\varepsilon_0}$$

仕事関数実効値

$$\phi_{\rm eff} = \phi_{\rm W} - \sqrt{e^3 E_{\rm RF} / 4\pi \varepsilon_0}$$

D. H. Dowell et al., Phys. Rev. STAB 9(2006) 063502

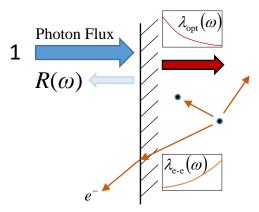
量子効率

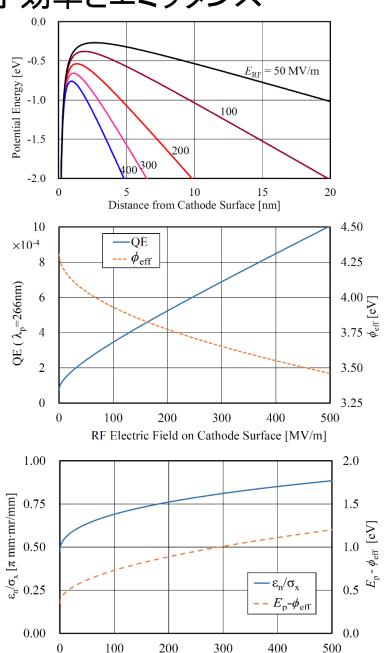
$$QE(\omega) = \frac{1 - R(\omega)}{1 + \lambda_{opt}(\omega)/\lambda_{e-e}(\omega)} \frac{E_F + \hbar\omega}{2\hbar\omega} \left[1 - \sqrt{\frac{E_F + \phi_{eff}}{E_F + \hbar\omega}} \right]^2$$

規格化エミッタンス

$$\varepsilon_n = \sigma_x \sqrt{\frac{\hbar \omega - \phi_{\text{eff}}}{3mc^2}}$$

$$\lambda_{\rm p}=266~{\rm nm}$$
で試算

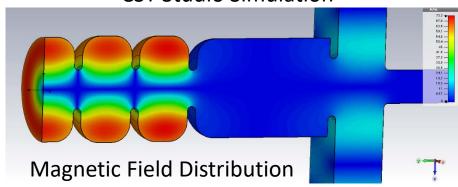




RF Electric Field on Cathode Surface [MV/m]

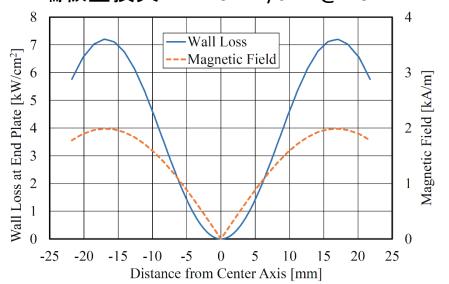
大電力入力による空洞特性への影響 ー温度上昇ー

CST Studio Simulation



- ・左端板中心軸から17mmで磁場が最大
- 外周部ではその90% → 損失電力は81%

最大磁場振幅 1.99 kA/m @ 4 MW 端板壁損失 7.20 kW/cm² @ 20 K



RFパルスによる温度変化

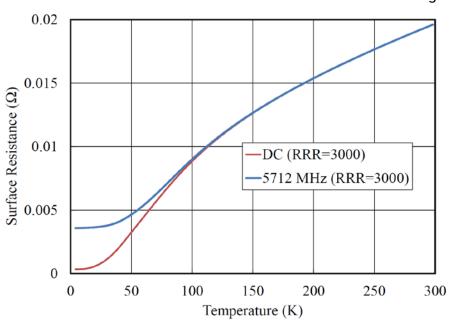
(D. P. Pritskau, Dissertation, Stanford university)

$$\Delta T(t) = \int_0^t \frac{dP(t',T)}{dA} \frac{1}{\sqrt{\pi \rho K(T)C_P(T)}} \frac{dt'}{\sqrt{t-t'}}$$

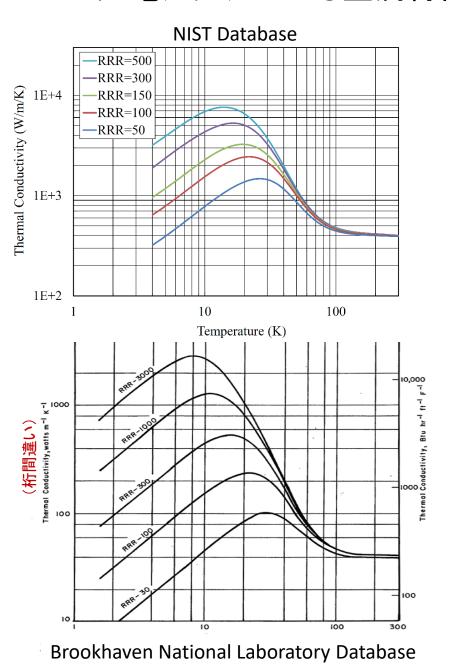
$$\frac{dP}{dA} = \frac{1}{2}R_S J^2 = \frac{1}{2}R_S |H_{\parallel}|^2 (単位面積当たり発熱)$$

 ρ : 密度、 C_p : 比熱、K: 熱伝導率

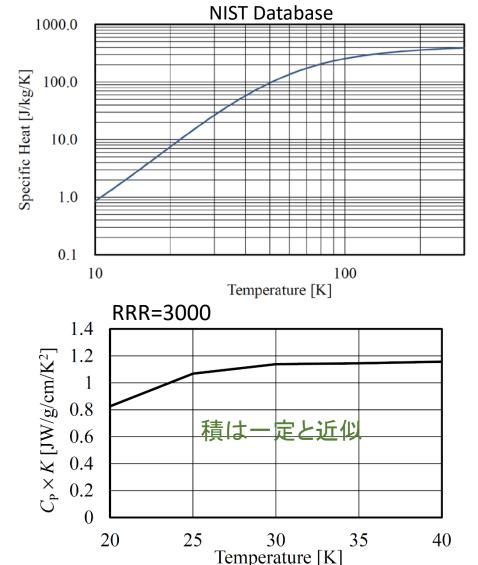
RRR=3000 高純度銅の空洞表面抵抗 Rs



大電力入力による空洞特性への影響 一温度上昇一

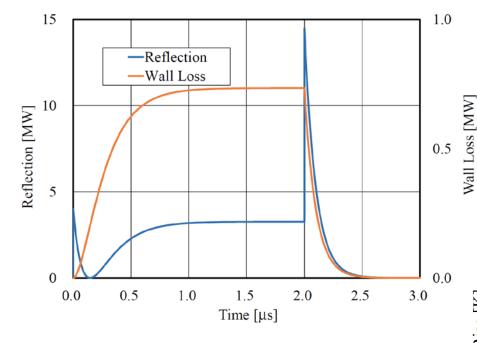


$$\Delta T(t) = \int_0^t \frac{dP(t',T)}{dA} \frac{1}{\sqrt{\pi \rho K(T)C_P(T)}} \frac{dt'}{\sqrt{t-t'}}$$



大電力入力による空洞特性への影響 ー温度上昇ー

4 MW、パルス幅2μs入力における反射電力と空洞内損失電力の波形



一定値と近似した20 Kでの物性数値

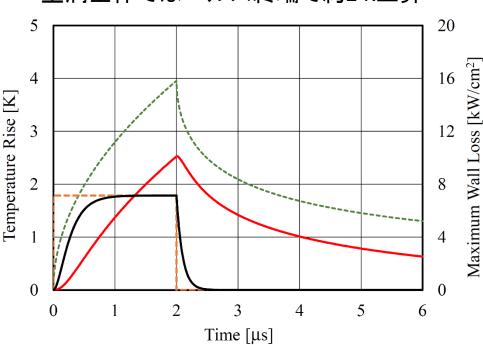
 $R_{\rm S} = 0.003645 \,\Omega$

 $C_{\rm P} = 0.01 \,{\rm J/g/K}$

K = 90 W/cm/K

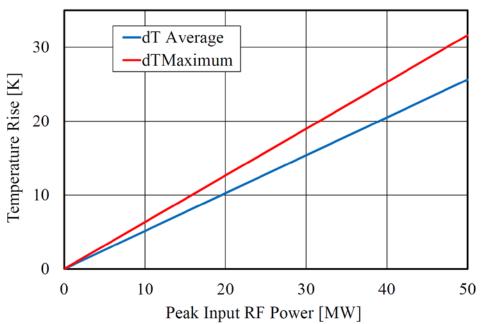
 $\rho = 9.0 \, \text{g/cm}^3$

最大磁場部分の温度上昇計算結果 空洞全体ではパルス終端で約2 K上昇



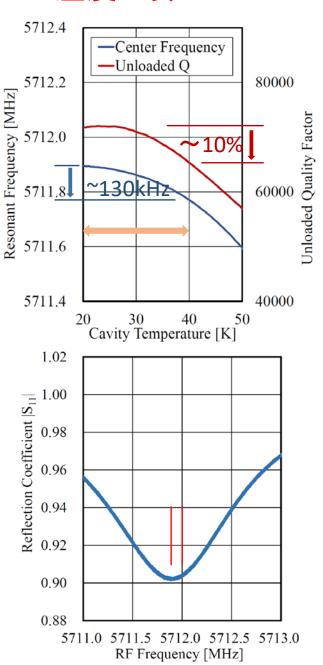
大電力入力による空洞特性への影響 ー温度上昇ー

20 K を基準とした計算結果 空洞温度上昇の入力RF電力依存性



Q値および共振周波数への影響 (20 Kを基準に定常状態からの推定)

- 10 K程度の温度上昇はほぼ影響なし → 20 MW入力程度まで問題なし(?)
- 20 Kの温度上昇Q₀が10%低下、共振周波数が130kHz 低下しても、動作の破綻はない
 - →ピーク共振周波数から130kHz低下しても空洞電界 の低下は1.5%以内



Qの低下による結合係数変化の影響

$$Q_{0} = \beta Q_{\text{ext}}$$

$$Q_{\text{ext}} = \text{const.}$$

$$Z \propto Q_{0} \propto \beta$$

$$\beta = \beta_{0} + \Delta \beta$$

$$V_{\text{acc}} = \frac{2\sqrt{\beta}}{1+\beta} \sqrt{PZT^{2}L} \approx \left\{1 + \frac{\Delta \beta}{\beta_{0}(1+\beta_{0})}\right\} \frac{2\sqrt{\beta}}{1+\beta_{0}} \sqrt{PZ_{0}T^{2}L}$$

$$\approx -0.005$$

 Q_0 の10%低下は1次近似では電界の変化がほぼ無視できる。



空洞放電時の電界がほぼ正確に推定できる。

まとめ

- 20 K 冷却Cバンド光陰極RF電子銃用試験空洞の低電力試験結果に基づき 当初予定のピーク4MWを遥かに超える大電力RF入力における空洞動作を 検討。
- RF入力による空洞温度上昇を評価し、空洞特性に及ぼす影響を考察。
- ・ 空洞温度の上昇10K程度までは、空洞特性の変化は小さい。
- ・ 温度上昇が20K程度までになると、無負荷Q値の低下に伴い、加速電界の変化は無視できるが、空洞消費電力は10%増加するため、さらに若干空洞温度が上昇すると予想。
- ・ パルス幅 2µs、ピーク40 MWの入力で空洞平均温度が20 K程度上昇。
- 空洞温度上昇は、20 K冷却2.6セルRF電子銃空洞における高電界放電頻度 の測定実験には支障ない。
- ・ 低温冷却高電界RF電子銃で、短パルスレーザー照射による短バンチビーム 生成の可能性。